

【 📢七月份專利獲證清單資料，共5件🌟】

2024年08月31日 (六) 13:54

★七月份獲證專利清單如下(共5件)：

1、

技術領域	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日
電子與光電	晶體振盪器及其製作方法	日本	洪瑞華, 林逸倫	特許7521731	2024-07-16
摘要					
A crystal oscillator includes a piezoelectric substrate, a first electrode, a second electrode, and a support frame. The first electrode includes a first electrode portion disposed on a first surface of the piezoelectric substrate. The second electrode is disposed on a second surface of the piezoelectric substrate opposite to the first surface of the piezoelectric substrate. The support frame is made of a photoresist material, and is disposed on the second surface. The support frame surrounds the second electrode portion. At least a portion of the second extending electrode portion is located outside the support frame. A method for making the crystal oscillator is also provided herein.					

2、

技術領域	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日
微機電與自動化系統	PATH PLANNING METHOD AND SYSTEM USING THE SAME	美國	郭峻因, 張仁碩	US 12,039,788 B2	2024-07-16
摘要					
A path planning system includes an image-capturing device, a point-cloud map-retrieving device, and a processing device. The image-capturing device captures a first and a second camera road image. The point-cloud map-retrieving device retrieves distance data points to create a road distance point-cloud map. The processing device receives the road distance point-cloud map and the first and second camera road images, calibrates and fuses those to generate a road camera point-cloud fusion map, and then determines the road-line information of the second camera road image to generate a road-segmented map. The road-segmented map and the road camera point-cloud fusion map are fused. The distance data of the road-segmented map are obtained according to distance data points. A front driving path for the target road is planned according to the distance data.					

3、

技術領域	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日
光電半導體技術、平面顯示技術、軟性電子技術	透明薄膜電晶體型光感測元件的製作方法	台灣	劉柏村, 邱昱銓, 黃家琳	1848517	2024-07-11
摘要					
一種透明薄膜電晶體型光感測元件的製作方法，準備一包括一閘極層的半導體基板單元，接著，以電漿輔助原子層沉積法在該閘極層上沉積形成一由高介電常數材料所構成的閘極絕緣層，再以濺鍍方式在該閘極絕緣層上形成一由氧化銻基材料所構成的感測通道層，並對該感測通道層進行氮摻雜，最後在該感測通道層上形成一源極與一汲極。					

4、

技術領域	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日
材料化工與奈米	NANO-TWINNED Cu-Ni ALLOY LAYER AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	美國	陳智, 李康平, 張祐懌, 陳昀萱	US 12,037,670 B2	2024-07-16
摘要					
A nano-twinned Cu—Ni alloy layer is provided, wherein more than 50% in volume of the nano-twinned Cu—Ni alloy layer comprises plural twinned grains, the plural twinned grains comprise plural columnar twinned grains, and a Ni content in the nano-twinned Cu—Ni alloy layer is in a range from 0.05 at % to 20 at %. In addition, a method for manufacturing the aforesaid nano-twinned Cu—Ni alloy layer is also provided.					

5、

技術領域	專利名稱	國別	發明人	證書號	取證日
電子材料與零組件、 複合材料、奈米材料 技術、醫療工程及醫 療器材、生醫材料與 組織工程、奈米生醫 技術	黏彈性電極貼片及其製 造方法	台灣	黃薇蕤,林峻璋	1850101	2024-07-21
摘要					
<p>本發明為一種黏彈性電極貼片及其製造方法，包含於基板上形成薄膜層；於薄膜層進行圖案化處理，使得薄膜層形成圖案化區域，於圖案化區域形成導電迴路層，導電迴路層包含奈米金屬線材料，於導電迴路層上形成黏彈性層，黏彈性層是包含聚多巴胺的膠體所形成，以及移除基板與薄膜層，製得黏彈性電極貼片。藉由奈米金屬線彼此接觸來形成迴路，因此可以在較小的體積中，提供傳遞度佳與靈敏度佳的功效。此外，黏彈性層具有容易黏貼到物體上或者從物體上移除的功效。</p>					

活動承辦人

智權管理及推動中心